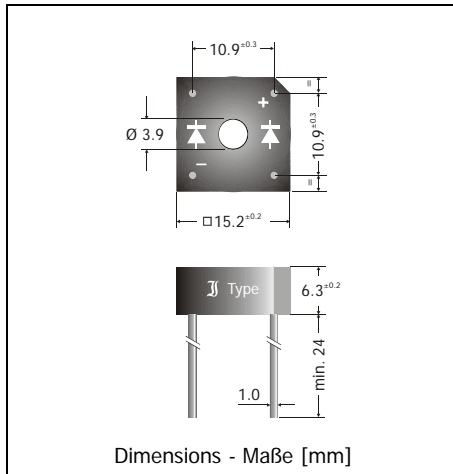


DD810

Silicon Twin Rectifiers Silizium-Doppeldioden

Version 2006-02-17



Nominal current Nennstrom	10 A
Alternating input voltage Eingangswchelspannung	1000 V
Plastic case Kunststoffgehäuse	15.2 x 15.2 x 6.3 [mm]
Weight approx. Gewicht ca.	3.5 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 Klassifiziert	
Standard packaging bulk Standard Lieferform lose im Karton	



Maximum ratings

Grenzwerte

Type Typ	Max. alternating input voltage Max. Eingangswchelspannung V_{VRMS} [V]	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V] ¹⁾
DD810	1000	1000

Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom mit R-Last	per diode pro Diode	I_{FAV}	10 A ²⁾
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	160/190 A
Rating for fusing, $t < 10$ ms Grenzlastintegral, $t < 10$ ms	$T_A = 25^\circ\text{C}$	i^2t	160 A ² s
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_j T_s	-50...+150°C -50...+150°C

Characteristics

Kennwerte

Forward voltage – Durchlass-Spannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $I_F = 8$ A	V_F	< 1.1 V ¹⁾
Leakage current – Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $V_R = V_{RRM}$	I_R	< 10 µA
Thermal resistance junction to case Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse		R_{thJC}	< 3.3 K/W
Admissible torque for mounting Zulässiges Anzugsdrehmoment		M 4	$9 \pm 10\%$ lb.in. $1 \pm 10\%$ Nm

1 Per diode – Pro Diode

2 Valid, if leads are kept to ambient temperature $T_A = 50^\circ\text{C}$ at a distance of 5 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 5 mm vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur $T_A = 50^\circ\text{C}$ gehalten werden

